PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-022213

(43)Date of publication of application: 24.01.1995

(51)Int.Cl.

H01C 10/00 H05K 3/34

(21)Application number : 05-166663

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

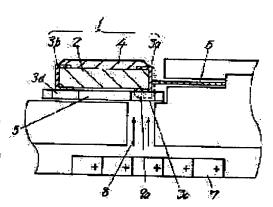
(22)Date of filing:

06.07.1993

(72)Inventor: MITSUMURA OSAMU

(54) METHOD FOR FORMING SOLDER BUMP ON SURFACE MOUNTING COMPONENT (57)Abstract:

PURPOSE: To form a thick solder bump on a surface mounting component, e.g. a chip resistor or a semifixed chip resistor employed in an electronic appliance, by feeding power continuously to an outer electrode in a plating liquid without relying on the conventional technology, e.g. presoldering method or barrel plating method, in which the thickness of solder is limited. CONSTITUTION: Chip resistors 1 are set on a carrier tape 5 and carried continuously to a plating bath where power is fed continuously from a power supply electrode 6 to the primary electrode 3a of the chip resistor 1 and the anode 7 is disposed just under the primary electrode 3a thus forming a solder bump 9a selectively. Since a thick solder bump 9a is formed by plating, additional solder supply is not required at the time of mounting on a circuit board, resulting in the enhancement of reliability and efficiency in the mounting.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

06.07.2000

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3180515

[Date of registration]

20.04.2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(川)特許出國公開發导

特開平7-22213

(43)公開日 平成7年(1995)1月24日

(51) Int.CL! \$PP配号

庁内整理番号 PI

技術表示的所

H01C 10/00 H05K 3/34 N 505 E 7128-4E

審査請求 京請求 菌求項の数1 OL (全 3 頁)

(21)出顧番号

(22)出驗日

物顧平5-166663

平成5年(1993)7月6日

(71)出廢人 000005821

松下電器產業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番池

(72)発明者 三ツ村 修

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

应录练式会社内

(74)代理人 弁理士 小假治 明 (外2名)

(54) 【発明の名称】 面実装部品への半田パンプ形成方法

(57)【要約】

【目的】 電子機器に使用されるチップ抵抗、チップ半固定抵抗などの面実装部品への半田バンプの形成は、予備半田法、バレルメッキ法等の従来技術では、必要な半田厚付けに限界があった。本発明はメッキ液中で連続的に外部電極に給電することにより、半田メッキを厚付けした半田バンプを形成する。

【構成】 キャリアテープ5にチップ抵抗1を終着して 連続的にメッキ槽へ鉄送し、給電電極6によってチップ 抵抗1の一次電極3 a に連続的に給電し、陽極7を一次 電極3 a の真下に配置することにより、選択的に半田バ ンプ9 a を形成する。

【効果】 半田メッキを厚付けして半田バンプ9 a を形成するので、回路基板への実装時に新たな半田の供給をする必要がなくなり、実装の信頼性と実装効率の向上をはかることができる。

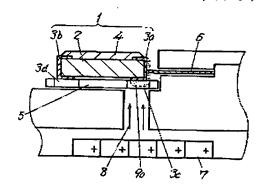
/ テップ抵抗 (面実系部品)

2 絶縁基板 32,33 - 次電極 5 キャリアテープ (撤送手段)

6 給電電極

7陽 極

% 学田バンプ



(2)

特開平7-22213

【特許請求の範囲】

【請求項】】 あらかじめ絶縁基板上に形成した一次電 極を有する面実装部品を連続的にメッキ槽内へ搬送する 搬送手段と、前記一次電極にメッキ液中で当接して連続 的に給電する給電電極とを備えたメッキ工法において、 前記一次電極上の隔極側に選択的に半田メッキを厚付け して半田バンプを形成する面突装部島への半田バンブ形 成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は各種電子機器に使用され るチップ抵抗。チップ半固定抵抗等の面真装部品への半 圏バンブ形成方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、この種の面真装部品への半田バン フ形成方法には、Ag-Pd電極上に溶融半田による予 備半田法またはAg系電便からなる一次電極上にバレル 工法等による電解NIおよび電解半田メッキによって半 田電極を形成していた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 予備半田法およびバレルメッキ法による半田電極は、膻 厚3~10μμα程度を均一な半因膜として形成してい た。したがって、回路基板等への実装時には、クリーム 半田印刷による半田の供給を必要としていた。

【0004】近年、電子機器の小型、薄型化の進展は著 しく、電子部品も1.0×0.5チップ抵抗等の敵小部 品の需要が高まっている。このような微小部品の半田付 けには、クリーム半田に使用する半田錠の形状管理、ま 良の大部分が半田付け工程に起因するといっても過言で はない。

【0005】本発明は、上記問題を解決するもので、ク リーム半田等の供給を不要とすることにより、面実装部 品の実装作業の信頼性を高め、実装工程の効率化をはか ることを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は上記目的を達成 するために、あらかじめ絶縁基板上に形成した一次電極 を有する面突鉄部品を連続的にメッキ槽内へ鍛送する鐵 40 送手段と、前記一次電極にメッキ液中で当接して連続的 に給電する給電電極とを備えたメッキ工法において、前 記一次電極上の陽極側に選択的に半田メッキを厚付けし て半田バンブを形成するものである。

[0007]

【作用】上記した方法において、一次電極上の陽極側に 選択的に半田メッキを厚付けして半田バンプを形成する ので、回転基板への真装時に新たな半田を供給する必要 がなくなるものである。

1000081

【実施例】以下、本発明の一実施例について、図1~図 3を参照しながら説明する。図において、1はチップ抵 抗であり、2はアルミナからなる絶縁差板、3a、3b はAgメタルグレーズからなる一次電便、Aは最上層の ガラス層である。5はチップ抵抗1を鉄着して連続的に メッキ層内へ振送する一次電極3a.3りと接する部分 に孔部3c, 3dを有するキャリアテープであり、6は 一次電極3 a に連続的に給電するための給電電極 7 は 10 半田メッキ陽極(Sn-Pb)、8は半田メッキ液流を 示す。

【0009】上記機成において、一次電極3aに結電電 極6によって負電位が与えられると 一次電極3 a の表 面で半田メッキの析出反応がおこり、半田バンプ9aが 形成される。この反応速度は、半田メッキ液流8が大き いほど、また陽極?との距離に反比例して大きくなる。 本発明では陽極?を一次電極3aの真下に配置すると と、および給電電極6にて連続給電を行うことにより、 メッキ析出速度を上げることができ、一次電極3 a の隔 20 極側に選択的に半田メッキを厚付けすることができる。 【0010】なお、チップ抵抗1の反対側の一次電極3 りへの半田バンプ9 りの形成も同様の方法で行う。ま た。実施例ではチョフ抵抗1について説明したが、チョ プ半固定抵抗についても同様の半田バンブ形成方法によ って半田メッキの析出反応が可能である。

[0011]

【発明の効果】上記実施例から明らかなように本発明の 面実装部品への半田バンブ形成方法は、一次電極の真下 に陽極を配置することにより選択的に半田メッキを厚付 たファインパターン印刷技術等には問題があり、実装不 30 けして半田パンプを形成するものであり、この形成方法 により、従来の工法では不可能だった半田バンブの形成 が可能となり、半田バンブ付き面真装部品を供給するこ とにより、実鉄の信頼性と実装効率の向上をはかること ができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一葉施例における面実装部品への半田 バンプ形成方法の構成図

【図2】同半田バンプ成形方法に用いるチップ抵抗の断

- 【図3】間チップ抵抗に半田メッキを施した断面図 【符号の説明】
 - 1 チップ抵抗(面突装部品)
 - 2 維緩基板
 - 3 a . 3 b 一次電極
 - 5 キャリアテープ (銀送手段)
 - 6 鉛電電極
 - 7 陽極
 - 9a、9b 半田バンプ

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401...

9/19/2006

(3)

特開平7-22213

[図2]

